Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá Trường Đại học Hồng Đức	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ Mã hồ sơ:	ẢNH 4x6

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☑; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☑; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Lương Thị Kim Phượng

2. Ngày tháng năm sinh: 15/3/1981. Nam ☐; Nữ ☑; Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Phật giáo

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☑

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 51 Trần Huy Liệu, Phố Nam Cao, Phường Tân Sơn, Thành Phố Thanh Hoá.

6. Địa chỉ liên hệ: SN 51 đường Trần Huy Liệu, Phố Nam Cao, Phường Tân Sơn, Thành Phố Thanh Hoá.

Điện thoại nhà riêng: Điện thoại di động: 0904621503;

Địa chỉ E-mail: luongthikimphuong@hdu.edu.vn

7. Quá trình công tác:

– Từ năm 09/2004 đến năm 08/2007: Giáo viên, Trường Trung học Phổ thông Thiệu Hoá, (Thieu Hoa high School) Thị trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

– Từ năm 11/2003 đến năm 09/2004: Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Yên ĐỊnh 1, (Yen Dinh 1 High School) Thị trấn Yên Định, Huyện Yên ĐỊnh, Tỉnh Thanh Hoá.

Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học.

Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ): Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học; Trường Đại học Hồng Đức; Bộ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá.

Điện thoại cơ quan: 02373910222.

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học;: Không có.

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ..... năm .....

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): .....

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

.....

9. Học vị:

– Được cấp bằng ĐH ngày 04 tháng 08 năm 2003, ngành Physics, chuyên ngành: Sư phạm Vật lý

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Hồng Đức/565 Quang Trung, phường Đông Vệ, Thành Phố Thanh Hoá

– Được cấp bằng ThS ngày 09 tháng 05 năm 2007, ngành Vật lý, chuyên ngành: Khoa học Vật Liệu

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội/Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Được cấp bằng TS ngày 18 tháng 02 năm 2015, ngành Vật lý, chuyên ngành: Khoa học Vật Liệu

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Aix-Marseille, Cộng hoà Pháp/CINaM - UMR 7325, CNRS - Aix Marseille Université Campus de Luminy – Case 913, 13288 MARSEILLE Cedex 09

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS thời gian: Không có., ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Hồng Đức.

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Hội đồng ngành Vật lý.

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

1. Nghiên cứu về vật liệu quang Ge/Si ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tích hợp

2. Nghiên cứu về vật liệu sắt điện không chì Bi0.5Na0.5TiO3 dung dịch rắn với MTiO3 (M là kim loại chuyển tiếp)

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 4 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;
- Đã công bố (số lượng) 16 bài báo KH trong nước, 11 bài báo KH trên tạp chí có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) ..... bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó có 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất:

Bài báo khoa học tiêu biểu

TT	Tên bài báo	Tên tác giả	Loại công bố (chỉ số IF)	Tên tạp chí, kỉ yếu khoa học	Tập	Số	Trang	Năm xuất bản
1	Enhanced Tensile Strain in P-doped Ge Films Grown by Molecular Beam Epitaxy Using GaP and Sb Solid Sources	T.K.P. LUONG, V. LE THANH, A. GHRIB, M. EL KURDI, and P. BOUCAUD	ISI (KHTN-CN) (IF: 1,566)	`Journal of Electronic Materials	48	7	4674	2019
2	The efficiency of carbon adsorption as a diffusion barrier in Ge/Si heterostructures	T K P Luong, V Le Thanh, A Ghrib M El Kurdi and P Boucaud	ISI (KHTN-CN) (IF: 1,902)	Physica Scripta		94	085803	2019
3	The suppression of out-diffusion effect by the HfO2 diffusion barrier for highly n-doped Ge epilayers grown on Si(001) substrate	Luong Thi Kim Phuong, Mohammad Zrir	Khác	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên	181	5	99 - 103	2018

4	Molecular-beam epitaxial growth of tensile-strained and n-doped Ge/Si(001) films using a GaP decomposition source	T.K.P. Luong, A. Ghrib, M.T. Dau, M.A. Zrir, M. Stoffel, V. Le Thanh, R. Daineche, T.G. Le, V. Heresanu, O. Abbes, M. Petit, M. El Kurdi, P. Boucaud, H. Rinnert, J. Murota	ISI (KHTN-CN) (IF: 1,867)	Thin Solid Film	557		70–75	2014
5	Control of tensile strain and interdiffusion in Ge/Si(001) epilayers grown by molecular-beam epitaxy	T. K. P. Luong, M. T. Dau, M. A. Zrir, M. Stoffel,2V. Le Thanh, M. Petit, A. Ghrib, M. El Kurdi, P. Boucaud, H. Rinnert, and J. Murota	ISI (KHTN-CN) (IF: 2,185)	Journal of Applied Physics	114		083504	2013

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

– Chiến sĩ thi đua năm học 2014-2015, cấp Trường Đại học Hồng Đức.

– Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017-2018, cấp Trường Đại học Hồng Đức.

– Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018-2019, cấp Trường Đại học Hồng Đức.

– Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2014-2015, cấp Trường Đại học Hồng Đức.

– Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016, cấp Trường Đại học Hồng Đức.

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): Không có.

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Trong 12 năm công tác kể từ năm 2007, tôi đã giảng dạy nhiều học phần chuyên ngành Vật lý cho sinh viên chính quy và học viên cao học của trường Đại học Hồng Đức. Tham gia phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn. Trong thời gian đó, tôi thường xuyên học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của người giảng viên. Bên cạnh đó, tôi đã tích cực trau dồi khả năng ngoại ngữ và đã được nhận học bổng tiến sĩ của chính phủ Việt Nam (theo đề án 322) tại cộng hoà Pháp. Tôi đã cố gắng vượt khó, thu xếp việc gia đình để hoàn thành luận án tiến sĩ tại Pháp trước thời hạn 09 tháng và trở về trường Đại học Hồng Đức công tác. Tôi luôn cập nhật kiến thức mới và áp dụng các phương pháp phù hợp trong quá trình giảng dạy các học phần ở bậc đại học và sau đại học. Tích cực tham gia các hội thảo quốc gia, quốc tế để tiếp thu những kiến thức mới và các xu hướng nghiên cứu trên thế giới. Từ tháng 4/2014-12/2016 với tư cách là Phó trưởng bộ môn Vật lý kỹ thuật và được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Vật lý chất rắn, tôi luôn sát sao với công việc từ việc tuyển sinh, cho đến việc giảng dạy và hướng dẫn luận văn thạc sĩ. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đào tạo của chuyên ngành thì tôi đã chủ trì việc cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Vật lý chất rắn. Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giảng viên và xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn của chức danh Phó giáo sư, mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

Tổng số 12 năm.

Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

TT	Năm học	Hướng dẫn NCS		HD luận văn ThS	HD đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH	Giảng dạy		Tổng số giờ giảng/số giờ quy đổi
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2007-2008	0	0	0	0	136	0	136/344
2	2008-2009(Học tiếng Anh đề án)	0	0	0	0	0	0	
3	2009-2010(5 tháng học Tiếng Anh)	0	0	0	0	68	0	68/205
4	2010-2014 (Đi NCS tại CH Pháp)	0	0	0	0	0	0	
5	2014-2015	0	0	0	0	117	67	184,5/285
6	2015-2016	0	0	0	0	153	67	247,5/321
3 thâm niên cuối								
1	2016-2017(Nghỉ sinh 06 tháng)	0	0	50	0	0	67	67,5/135
2	2017-2018(lên phòng QLĐT SĐH	0	0	100	0	0	67	67,5/180
3	2018-2019	0	0	50	0	0	202	202,5/285

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☑:

– Học ĐH ☐; Tại nước: từ năm:

– Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ☑; Tại nước: France năm: 2014

– Thực tập dài hạn (> 2 năm) ☐; Tại nước:

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐ :

– Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ... ; Số bằng: ... ; Năm cấp: ...

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☑ :

– Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành

– Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Đại học Hồng Đức

d) Đối tượng khác ☐ ; Diễn giải: .....

3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): TOEFL-ibt (70)

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng):

TT	Họ tên NCS hoặc HV	Đối tượng		Trách nhiệm HD		Thời gian hướng dẫn từ .....đến.....	Cơ sở đào tạo	Năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HV	Chính	Phụ			
1	Nguyễn Trung Hiếu		✓	✓		12/2015 đến 06/2016	Trường Đại học Hồng Đức	2016
2	Lưu Thị Minh Phương		✓	✓		01/2017 đến 07/2017	Trường Đại học Hồng Đức	2017
3	Lê Trung Dũng		✓	✓		01/2017 đến 07/2017	Trường Đại học Hồng Đức	2017
4	Trịnh Trúc Ly		✓	✓		12/2017 đến 06/2018	Trường Đại học Hồng Đức	2018

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ Không có

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ Không có

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức danh PGS):

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)
1	Nghiên cứu chế tạo màng mỏng epitaxy Germani trên Silic có ứng xuất căng và pha tạp điện tử với mật độ cao nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tích hợp	Chủ nhiệm	103.02-2015.106, Nhà nước	05/2016 đến 05/2019	19/06/2019

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1. Bài báo khoa học đã công bố:

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF) (*)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/Số	Trang	Năm công bố
1	Molecular-beam epitaxial growth of tensile-strained and n-doped Ge/Si(001) films using a GaP decomposition source	15	Thin Solid Film	ISI (KHTN-CN) (IF: 1,867)	21	557/	70–75	2014
2	Epitaxial growth of high curie temperature Ge1-xMnx quantum dots on Si(001) by self-assembly	2	Communication in Physics	Khác		24/1	69-77	2014
3	Germanium band gap engineering induced by Tensile strain for Si-based optoelectronic applications	2	Communication in Physics	Khác		23/4	367-375	2013
4	Control of tensile strain and interdiffusion in Ge/Si(001) epilayers grown by molecular-beam epitaxy	11	Journal of Applied Physics	ISI (KHTN-CN) (IF: 2,185)	53	114/	083504	2013
5	The effects of Mn concentration on structural and magnetic properties of Ge1-xMnx diluted magnetic semiconductors	8	Journal of Physics	ISI (KHTN-CN) (IF: 2,168)	9	292/	012012	2011
6	Màng dẫn sóng phẳng SiO2-TiO2-B2O3 pha tạp Er3+ quá trình chế tạo và các tính chất	5	Tuyển tập các báo cáo hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ V	Khác		/	632-635	2007
7	Silica-Aluminar xerogel đồng pha tạp Er3+ và Yb3+: quá trình chế tạo và các tính chất	5	Tuyển tập các báo cáo Hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ VI	Khác		1/	370-373	2005

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF) (*)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/Số	Trang	Năm công bố
8	Enhanced Tensile Strain in P-doped Ge Films Grown by Molecular Beam Epitaxy Using GaP and Sb Solid Sources	5	`Journal of Electronic Materials	ISI (KHTN-CN) (IF: 1,566)		48/7	4674	2019
9	The efficiency of carbon adsorption as a diffusion barrier in Ge/Si heterostructures	5	Physica Scripta	ISI (KHTN-CN) (IF: 1,902)		/94	085803	2019
10	Magnetic properties of (1−x)Bi0.5Na0.5TiO3+xMnTiO3 materials	7	Journal of Magnetism and Magnetic Materials	ISI (KHTN-CN) (IF: 3,046)		/471	164-168	2019
11	Nghiên cứu chế tạo diode phát quang trên nền vật liệu Ge/Si pha tạp điện tử mật độ cao ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử tích hợp	1	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên	Khác		11/204	17-22	2019
12	Ảnh hưởng của nguyên tố Sb đến tính chất quang của màng Ge/Si đồng pha tạp Sb và P	1	Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Hồng Đức	Khác		/		2019
13	Ảnh hưởng của điều kiện xử lý nhiệt đến tính chất quang của màng Ge/Si đồng pha tạp Sb và P	1	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân	Khác		34/3		2019
14	Nghiên cứu tính chất điện của màng Ge pha tạp điện tử từ nguồn rắn GaP và Sb bằng phương pháp epitaxy chùm phân tử	1	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên	Khác		/		2019
15	Ảnh hưởng của định hướng đế lên sự hình thành các màng GeMn	2	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên	Khác		/		2019
16	The effect of carbon element on optical properties of n-doped Ge on silicon substrate	1	Modern Physics Letter B	SCIE (KHTN-CN) (IF: 0,731)		32/	1850224	2018
17	A New Approach for Heavy N-Doping Process in Ge Epilayers Using Specific Solid Source	1	Optics and Photonics Journal	Khác	1	8/	11-19	2018
18	Khống chế sự hình thành tăng trưởng dạng đảo của germani trên đế siclic bằng phương pháp epitaxy chùm phân tử	1	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên	Khác		/181	35-40	2018
19	The suppression of out-diffusion effect by the HfO2 diffusion barrier for highly n-doped Ge epilayers grown on Si(001) substrate	2	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên	Khác		181/5	99 - 103	2018

20	Ảnh hưởng của nồng độ ion Al3+ và điều kiện công nghệ tới tính chất quang của màng silica-titania pha tạp ion Er3+ ứng dụng trong quang dẫn sóng	2	Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Hồng Đức	Khác		6/39	120	2018
21	Optical Properties of Sb Doped Ge Films Deposited on Silicon Substrate by Molecular Beam Epitaxy	6	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics			34/3	48-54	2018
22	Phương pháp xử lý bề mặt đế silic ở nhiệt độ thấp ứng dụng trong kỹ thuật tăng trưởng epitaxy chùm phân tử	1	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên	Khác		/185	57-62	2018
23	Nghiên cứu sự phân bố của các nguyên tử phốt pho pha tạp trong màng ge tăng trưởng epitaxy trên đế si(100) bằng kỹ thuật chụp cắt lớp đầu dò nguyên tử	1	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên	Khác		/189	79-84	2018
24	Tunable magnetic properties of Bi0.5Na0.5TiO3 materials via solid solution of NiTiO3	7	Applied Physics A	ISI (KHTN-CN) (IF: 1,604)		/124	588	2018
25	Nghiên cứu tính chất quang của màng silica-titania-alumina pha tạp Er3+ ứng dụng trong dẫn sóng phẳng	2	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng	Khác		3/124	104-107	2018
26	Making germanium, an indirect band gap semiconductor, suitable for light-emitting devices	5	Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology	Scopus (KHTN-CN) (IF: 1,5)	10	6/	015013	2015
27	Highly-doped, highly-strained Germanium and schottky Electroluminescent diodes	16	ECS Transactions	ISI (KHTN-CN) (IF: 3,266)		64/6	359-364	2014

- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

Chú thích: (*) gồm SCI, SCIE, ISI, Scopus (KHTN-CN); SSCI, A&HCI, ISI và Scopus (KHXH-NV); SCI nằm trong SCIE; SCIE nằm trong ISI; SSCI và A&HCI nằm trong ISI.

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích:

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ Không có.

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ Không có.

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...):

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ

Không có.

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ

Không có.

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học:

Không có.

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín:

- Thời gian được cấp bằng TS, được bổ nhiệm PGS: ☐
- Giờ chuẩn giảng dạy: ☐
- Công trình khoa học đã công bố: ☐
- Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ: ☐
- Hướng dẫn NCS, ThS: ☐

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày..... tháng..... năm 201...

Người đăng ký

(Ghi rõ họ tên, ký tên)

D. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NƠI ĐANG LÀM VIỆC

– Về những nội dung "Thông tin cá nhân" ứng viên đã kê khai.

– Về giai đoạn ứng viên công tác tại đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này.

(Những nội dung khác đã kê khai, ứng viên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật).

..., ngày.....tháng.....năm 201...

Thủ trưởng cơ quan

(Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu)